**Правила для авторов**

**1. Общие положения**

1. Сборник «Гетеромагнитная микроэлектроника» выходит 4 раза в год – 2 раза в год в открытом и 2 раза в год в ограниченном доступе (спецвыпуски) и публикует материалы теоретических и экспериментальных исследований полупроводниковых и магнитополупроводниковых микро- и наноэлектронных систем, включая системы с цифровой обработкой информации, новых типов датчиков, активных устройств (усилителей, генераторов, синтезаторов частот и др.), а также статьи о новых технологиях, методах и средствах контроля, о современном метрологическом обеспечении, подготовке и переподготовке кадров, прогнозно-аналитических исследованиях.
2. Объем статьи не должен превышать 16 страниц (1 печатного листа).
3. Для публикации статьи автору необходимо представить в редакцию следующие материалы и документы (1 экз.):
	* сопроводительное письмо;
	* внешнюю рецензию;
	* сведения об авторах: фамилии, имена и отчества (полностью), рабочий адрес, телефоны, e-mail;
	* экспертное заключение;
	* текст статьи на русском языке, подписанный авторами, а также название статьи, инициалы и фамилии авторов, аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках.

**2. Структура публикаций**

1. Рукопись оформляется следующим образом :
	* первая строка – индекс УДК, выровненный по левому краю текста;
	* вторая строка – заголовок статьи прописными буквами (шрифт полужирный, по центру) без переносов;
	* третья строка – перечень авторов (инициалы предшествуют фамилии), разделенный запятыми (шрифт полужирный, по центру);
	* четвертая строка – полное официальное название организации (при нескольких организациях каждое наименование на отдельной строке, шрифт обычный, по центру);
	* пятая строка – почтовый адрес (с индексом) организации (шрифт обычный, по центру);
	* затем аннотация и ключевые слова на русском языке.
2. Далее приводится заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, аннотация и ключевые слова на английском языке.
3. Далее текст статьи и библиографический список на русском языке.

**3. Требования к оформлению рукописи**

1. Текст статьи должен быть напечатан через одинарный интервал на белой бумаге формата А4 с полями не менее 2,5 см, размер шрифта 14. Дополнительный материал набирается шрифтом 12 (аннотации, таблицы, сноски, примечания, приложения, подписи и надписи к рисункам, содержание, библиографический список, выходные данные, колонтитулы).
2. Все страницы рукописи, включая библиографический список, таблицы, рисунки, следует пронумеровать по центру внизу страницы.
3. Векторные величины выделяются полужирным шрифтом.
4. Каждая таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь тематический заголовок, кратко раскрывающий ее содержание (выравнивание по левому краю таблицы. Например, Таблица 1. Требования к …). Точка в конце заголовка не ставится. Единицы измерения указываются после запятой. Ссылка на таблицу должна предшествовать ей.
5. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Обозначения и все надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин указывается через запятую. Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной без апелляции к тексту (например, Рис. 1. Зависимость …). Подписи к рисункам не должны выходить за его границы. Точка в конце подрисуночной подписи не ставится. Ссылка на рисунок должна предшествовать ему.
6. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Номер располагают по правому краю полосы по центру формулы.
7. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и открывается размещенным по центру заголовком. Все ссылки даются в квадратных скобках (например, [4]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Библиографическое описание оформляется следующим образом:

Образец описания книги:

1. *Игнатьев А. В., Ляшенко А. В.* Магнитоэлектроника СВЧ-, КВЧ-диапазонов в пленках ферритов. М. : Наука, 2005. 380 с.

Образец описания статьи в журнале:

1. *Игнатьев А.* *А*., *Страхова Л.* *Л*., *Овчинников С. В.* Профессиональная направленность современного курса физики для студентов-геофизиков классического университета // Физическое образование в вузах. 2002. № 2. С. 14–18.
2. *Poon H. C.* Modeling of bipolar transistor using integral charge control model with application to third-order distortion studies // IEEE Trans. 1972. Vol. ED-12, № 6. Р. 719–731.

Образец описания статьи в сборнике:

1. *Игнатьев А. А.*, *Ляшенко А. В*., *Солопов А. В*. О времени тепловой готовности феррит-транзисторного СВЧ-генератора на высоких уровнях мощности // Гетеромагнитная микроэлектроника : сб. докл. и ст. науч.-техн. совещ. Вып.1 : Многофункциональные комплексированные устройства и системы СВЧ- и КВЧ-диапазонов. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2004. С. 139–151.

Образец короткого описания патентов:

1. Пат. 72788 Российская Федерация, МПК7 H 01 L 43/08, H 01 L 27/14, G 01 R 33/05, G 01 R 33/04. Устройство для измерения магнитного поля */* заявителиИгнатьев А. А., Куликов М. Н., Ляшенко А. В., Романченко Л. А., Солопов А. А. ; патентообладатель ОАО «НИИ-Тантал». – № 20700125198U ; заявл. 03.07.2007 ; опубл. 27.04.2008.

**4. Требования к оформлению электронной версии**

* 1. Текст рукописи должен быть представлен в виде одного файла на дискете «3,5», CD или по электронной почте в формате Microsoft Word 97/2000, шрифт Times New Roman, размер шрифта в соответствии с п.3.1, межстрочный интервал одинарный, величина отступа 5 пробелов. Вся работа должна быть выполнена одной гарнитурой (Times New Roman).
	2. Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation, входящем в состав Microsoft Word. Греческие буквы должны набираться обычным шрифтом, латинские – курсивом. Запись химических элементов – обычным шрифтом. Векторы – полужирным шрифтом.
	3. Диаграммы, графики и фотографии должны быть выполнены в черно-белом цвете.
	4. Иллюстрации должны быть представлены в форматах TIFF, JPEG.

*Дискеты и рукописи не возвращаются*

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес : | Россия, 410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, ОАО «Институт критических технологий» |
| Тел. : | 8-(8452) 34-08-70 |
| Факс : | 8-(8452) 34-08-70 |
| E-mail : | kbkt@san.ru |